

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 2 部門第 3 区分
 【発行日】平成 25 年 1 月 10 日 (2013.1.10)

【公開番号】特開 2011-140101 (P2011-140101A)
 【公開日】平成 23 年 7 月 21 日 (2011.7.21)
 【年通号数】公開・登録公報 2011-029
 【出願番号】特願 2010-2884 (P2010-2884)
 【国際特許分類】

B 8 1 C 1/00 (2006.01)

C 2 5 D 1/00 (2006.01)

【 F I 】

B 8 1 C 1/00

C 2 5 D 1/00 3 8 1

【手続補正書】

【提出日】平成 24 年 11 月 19 日 (2012.11.19)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

導電性金属材料層が形成されたベース基板上に第 1 のレジスト層を形成し、前記第 1 のレジスト層に複数の第 1 の開口を形成する工程と、

前記第 1 の開口に導電性金属材料を充填し複数の固定ポストを形成し、前記第 1 のレジスト層を除去する工程と、

前記固定ポストを覆う犠牲層を形成し、前記犠牲層の上に第 2 のレジスト層を形成し、前記第 2 のレジスト層に設けた第 2 の開口に導電性金属材料を充填することで導電性金属材料を積層してデバイスを形成する工程と、

前記犠牲層の上に形成された第 2 のレジスト層と前記犠牲層を除去する工程とを含み、

前記固定ポストは 1 個のデバイスに対して少なくとも 2 個以上が割り当てられ、前記固定ポストと前記デバイスが重ならないように配置され、

前記犠牲層が除去されて前記デバイスが前記導電性金属材料層の上へと移動させられた時に、前記デバイスは前記固定ポストによって横方向の移動が制限されていることを特徴とする MEMS デバイスの製造方法。